# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-127816

(43)Date of publication of application: 30.05.1991

(51)Int.Cl.

H01L 21/027 G11B 7/125

G11B 7/14

(21)Application number: 01-267575

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

13.10.1989

(72)Inventor: TSUKAMOTO TAKEO

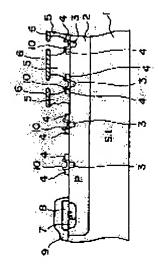
WATANABE NOBUO OKUNUKI MASAHIKO

## (54) MULTIPLE ELECTRON SOURCE

## (57)Abstract:

PURPOSE: To easily irradiate a moving article with an electron beam through a simple improvement by so setting an arraying direction of electron sources disposed along a longitudinal row as not to cross the arraying direction of electron sources disposed along a lateral row.

CONSTITUTION: The arraying direction of electron sources 3 disposed along a longitudinal row is so set as not to cross the arraying direction of electron sources 10 disposed along a lateral row. Thus, since the lateral and longitudinal directions of the matrixlike sources 3, 10 disposed on a board 1 are not perpendicularly crossed, if a moving article is continuously radiated with an electron beam from the sources 3, 10, the entire sources 3, 10 of one row can be sequentially driven (linearly and sequentially drive) under a pure control within time moving the article between the source 3 and the adjacent source 10. Thus, continuous electron beam irradiation region is formed by simple means, and signal setting for control is simplified, and further a control circuit is simplified due to the simplification.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-127816

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成3年(1991)5月30日

H 01 L 21/027 G 11 B 7/125 7/14

A 8947-5D

8947-5D 7013-5F 7013-5F

H 01 L 21/30

3 4 1 B

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

❷発明の名称 マルチ電子源

②特 願 平1-267575

②出 願 平1(1989)10月13日

 切発明者
 塚本
 健夫

 切発明者
 渡辺
 信男

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

**@**発明者 奥 貫 昌 彦

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

⑪出 願 人 キャノン株式会社

四代 理 人 弁理士 福森 久夫

#### 明細書

# 1. 発明の名称

マルチ電子源

#### 2. 特許請求の範囲

それぞれ電子ビームを放出する多数の電子類を 縦列および横列のマトリクス状に基板上に配置 し、射出された電子ビームを被照射体に照射すべ く各前記電子源を順次駆動するようにして成るマ ルチ電子源において、前記艇列に沿う前記電子源 の配列方向と前記横列に沿う前記電子源の配列方 向とを直交させないように設定したことを特徴と するマルチ電子源。

## 3. 発明の詳細な説明

### [産業上の利用分野]

本発明は、例えばレジスト描画用装置、電子ビーム記録用装置等のように、例えばショットキー型半導体電子額から放出する電子ビームを用いて微細かつ高密度の電子ビーム照射を行なうべく使用されるマルチ電子源に関するものである。

1

#### [従来技術]

従来、この種のマルチ電子源としては、例えば 米国特許第4259678号明細音、米国特許 4303930号明細音に記載されているような ものが知られている。これによると、マルチ電子 源は、多数の電子源が梃列および横列のマトリク ス状に基板上に配置され、各前記電子源を順次一 方向に駆動するようにして成り、各電子源の横の 配列方向(×方向)と梃の配列方向(y方向)と のなす角度が直交したいわゆる単純マトリクスで 配置した構成となっている。

#### [発明が解決しようとする課題]

しかしながら、上記従来技術の構成では、×方向とソ方向とのなす角度が直交しているので、例えば被照射体たる移動物体に向けて各電子源から電子ビームを移動物体上で連続的に照射させるようにしようとすると、各電子源は固定されていることから、移動物体の移動距離に応じて各電子源を一個ずつ個別に制御(いわゆる点順次駆動制御)しなければなら

ない。換官すれば、従来技術の構成は、制御用に 読み込ませるデータが多岐になること、電子ビー ムの放出制御が複雑であること、電子ビームの放 出のタイミング的余裕度が極めて制約される等の 問題があり実用性に乏しいものである。

本発明は、簡単な改良を加えることにより、特に移動物体に対する電子ビームの照射を容易に行なえるようにしたマルチ電子源を提供すること目的とする。

## [課題を解決するための手段]

[作用]

上記目的を達成すべく本発明は、それぞれ電子 ピームを放出する多数の電子類を段列および横列 のマトリクス状に基板上に配置し、放出された電 子ピームを被照射体に照射すべく各前記電子類を 順次駆動するようにして成るマルチ電子類におい て、前記縦列に沿う前記電子類の配列方向とを直交させな いように設定したことを特徴とする。

基板上に配置されたマトリクス状電子級の横列

3

は、配線用の階段状に形成された板状電極4が各イオン注入領域2と交叉するように、すなわち縦方向(各y方向a、b、c、d…)に形成されている。したがって、各y方向a、b、c、d…における各高濃度イオン注入領域3を結ぶ線と各×方向A、B、C、D…における各高濃度イオン注入領域3を結ぶ線とのなす角度は直交していない(X方向に沿う線(XーX線)とY・一Y・線とのなす角度のは90度よりも小である)。

さらに、前記イオン注入領域2上には、前記高 濃度イオン注入領域3から放出された電子を上方 に案内するべく脚状の電極5を介して平屋根状の 電極6が形成されている。

各前記イオン注入領域2の端部の表面部にはそれぞれ高濃度拡散層7が形成され。各高濃度拡散層7上にはオーミックコンタクト部8が夫々形成され、各オーミックコンタクト部8上には電極9がそれぞれ接続されている。また、各前記板状電極での端部にはそれぞれ電極11が接続されている。

方向と概列方向とが直交しないので、各電子源から移動物体上に連続的に電子ビームを照射する場合、移動物体が一つの電子源とこれに隣接する電子源との間を移動する時間内に、一の列の全部のマトリクス電子源を次々と駆動(線順次駆動)させるという単純な制御で行なえる。

#### [実施例]

第1図乃至第3図は第1の実施例を示すものである。図中1は例えば半絶緑性のGaAs墓板であり、該基板1上にはP型のイオン注入領域な2が横方向(×方向)に所定間隔を優いて直線状には入形成され、該各イオン注入領域2の表領域3が横方向(各×方向A、B、C、D・・・・)クス状に配置され、は入領域3は全体としてマトリクス状に配置された。ここで、高濃度イオン注入領域3は全体としてマトリクス状に配置されている。ここ、O・・・毎前記イオン注入領域2は

4

従って、マトリクス状に配列された各電子源は、各×方向A、B、C、D…の所定の電極9と各y方向a、b、c、d…の所定の電極10との間に逆パイアス電圧を印加すると、該両電極の交点位置にある電子原である高濃度イオン注入領域3がON状態となってアバランシェ増幅が生じ、当該高濃度イオン注入領域3からスポット状の電子が放出される。

なお、本実施例では電子源としてショットキー型半導体電子源を用いているが、特にショットキー型半導体電子源である必要はなく、PN接合、NEA(負の電子規和力)等の各種の半導体電子源を用いることが出来る。

次に、本実施例により電子ビームを移動物体に 照射し、連続的なビーム照射領域を形成するため の手順につき述べる。

まず、電子ビームが照射されるべき領域をマトリクス電子源に対向した位置に置く。この場合、例えば×方向Aの電極2と各y方向a、b、c、d…の電極4との交点位置の電子源をON状態に

するかOFF状態にするかは予め何らかの方法で 決められており、電極2と各y方向a, b, c, d…の電極4との間への逆パイアス電圧印加によ り、×方向Aの各電子源から顧次電子放出が生じ る。

次に同様な方法で他の X 方向 B , C , D …の電極 2 と各 y 方向 a , b , c , d …の電極 4 との間 への逆パイアス電圧印加により それぞれ線順次駆動する。

第4図は、マルチ電子源を電子ビームメモリに 適用した場合を示している。12は上記第1の実

7

第5図は、マルチ電子源を電子ビーム描画装置 に適用した場合を示している。同図において、マルチ半導体電子群12は上記第1の実施例で述べたと同様な構成のものである。19は半導体ウェハーであり、20はレジスト上に描かれた電子ビーム照射領域である。

前記マルチ電子源12の駆動手順は上記第2実施例とほぼ同様であるが、腹電子源12の駆動制

施例で述べたと同様な構成のマルチ半導体電子源、13はフォトダイオード、14は光を真空容器へ入れるための導入部、15は光信号を送るためのファイバー、16は高圧電源、17は電子源を駆動させるための電源、18は電子線配録媒体である。該記録媒体18としてはSiのMOS構造、アモルファス状のSiO:構造、A2:O: 膜およびSiN膜等の多層膜構造のものがある。

上記のように構成されているので、マルチ電子で12の駆動用の制御信号は、搬送クロックと同時に多重させ光信号として光ファイバー15を介して伝達され、フォトダイオード13で再び電気信号に戻される。マルチ電子で12は高圧電源16が接続されることにより高電圧になっているが、制御信号は光媒介としており、電気的に絶縁されているので耐ノイズ性に優れている。

マルチ電子源12の光制如信号は、フォトダイオード13で電気信号に変換され電気制御信号としての復調制御信号となる。該制御信号はマルチ

8

御はウェハー19のステージ移動に応じ、揺頭すべき全エリアにおいて電子添12を順次線駆動を 行う。

#### [発明の効果]

以上のように本発明によれば、それぞれ電子と一ムを放出する多数の電子源を級列および機列の電子源を級列および機列のマトリクス状に基板上に配置し、放出電子源を取出電子源は上に配置している。

現次に動きないでは、できるでは、できると共に、制御のに対したのでは、連続では、はののに対したのでは、連続では、はのに対したのでは、は、制御のに対したのでは、は、制御のに対したのに対したのに対したのに対したのに対したのに対している。

さらに、マルチ電子源をマトリクス状に構成して順次線駆動するため、移動体に同一の電子ビームの照射領域を形成しようとする場合、電子源が 一次元配列である場合に比べて、移動体の移動速 度を低下することができ、 該電子ピームの照射領域が楕円変形するのを小さくすることができる。また、電子ピームの照射領域を連続かつ高密度で形成できるので、電子線メモリ、 措面装置の他、電子線ブリンター等の広範囲の応用が可能となる。

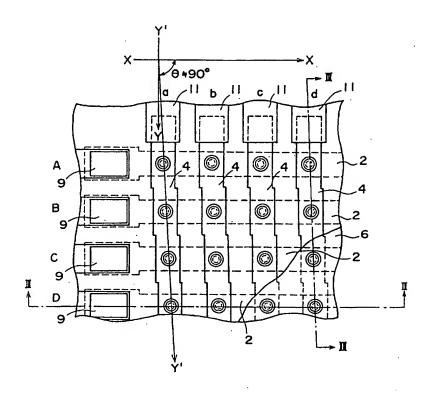
## 4. 図面の簡単な説明

第1図乃至第3図は本発明の一実施例を示すものであり、第1図はマルチ電子源の平面図、第2図は第1図のⅡ一Ⅱ線に沿う断面図、第3図は第1図のⅢ一Ⅲ線に沿う断面図、第4図は電子ビームメモリ装置への応用例を示す平面図、第5図は電子ビーム播画装置への応用例を示す平面図である。

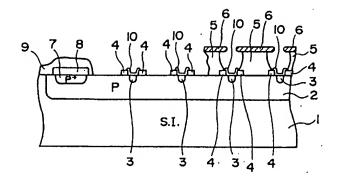
1 … 基板、 3 … P 型高濃度イオン注入領域(電子源)、 1 0 … ショットキー電極(電子源)、 1 2 … マルチ電子源。

1 1

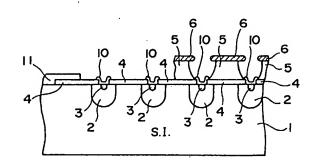
## 第 | 図



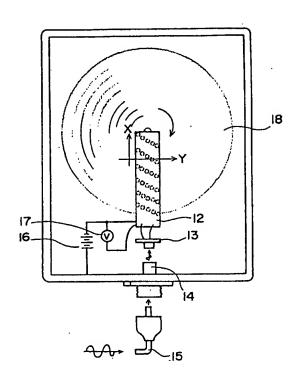
第 2 図



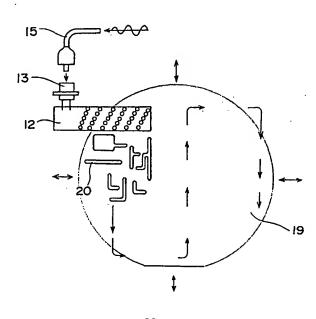
第 3 図



第 4 図



第 5 図



## 手統補正書(方式)



## 第 4 図

## 平成 2 年 2 月 6 日

特許庁長官 段

事件の表示
 平成元年特許顕第267575号

 発明の名称 マルチ電子額

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

名 称 (100)キャノン株式会社

代表者 山 路 敬 三

4.代理 人 〒180 電話03(358)8840

住 所 東京都新宿区本塩町 12

. 四谷ニューマンション107

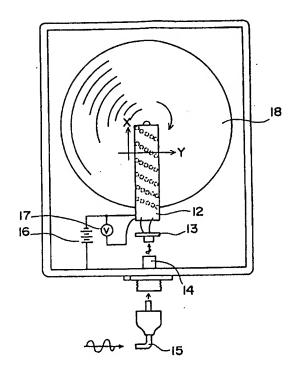
氏 名 (8809) 弁理士 福森久夫

5. 補正命令の日付(発送日) 平成2年 1月30日

6. 補正の対象図面(第4,5図)

図面 (第4,52 7. 補正の内容 別紙の通り





## 第 5 図

